

スパッタリング装置



スパッタリング装置
キャノンアネルバエンジニアリング（株）
E-200S

平成21年度導入

【主な用途・仕様】

スパッタリングによる各種薄膜の形成

- ・ プレーナマグネトロンカソード： $\phi 50.8\text{mm} \times 3$ 基
- ・ RF 電源： 1 基（最大投入電力 300W）
- ・ DC 電源： 2 基（最大投入電力 500W）
- ・ プロセスガス： Ar、O₂、N₂
- ・ 基板温度： 水冷 $\sim 300^{\circ}\text{C}$

【担当部署】 電子情報システム部：MEMS グループ

【設備使用の項目・使用料】 スパッタリング装置

【受託試験の項目・手数料】 マイクロマシニング加工（B）